速報

CO,パルスレーザによるサファイアウエハの熱応力割断

上田隆司*1, 三野大樹*2, 古本達明*1, 細川 晃*1, 長友正平*3

Laser cleaving of sapphire wafer with pulsed CO₂ laser

Takashi UEDA, Taiki MINO, Tatsuaki FURUMOTO, Akira HOSOKAWA and Syohei NAGATOMO

CO₂ パルスレーザを用いて単結晶のサファイアウエハの熱応力割断を試みている. レーザ割断はサファイアウエ ハを分断する方法として有力な加工法である. パルスレーザを用いると, 割断面には単結晶ウエハに特有な縞模様 が形成される. 曲線割断が可能であり, 円弧状にサファイアウエハを割断できる. ウエハ上に加工された浅い溝の 上を CO₂ パルスレーザでなぞることによって, ウエハを割断できる.

Key words: laser cleaving, sapphire wafer, CO2 laser, thermal stress, fracture toughness

1.緒 言

サファイアは高硬度のためにダイヤモンドブレードを用いて 高精度に切断することは容易ではない¹⁾²⁾.レーザによる熱応 力割断は、レーザ光をウエハに照射して、そのとき生じる熱応 力を活用してき裂を伝播させウエハを分断する加工法であり、 ダイヤモンドブレードによるダイシングに比べて取り代がいら ない、切りくずを生じない、加工液が不要であるなどの特長が あり、切りくずや廃液を生じない環境にやさしいエコ切断法の ーつとして注目されている³⁾.

著者らはこれまで、ガラスやシリコンウエハの他、SiC ウエハ、 InP ウエハなど電子デバイス用ウエハ⁴⁾、種々の構造用セラミ ックス⁵⁾などの硬脆材料をレーザ割断する方法について検討 してきた.新しい材料をレーザ割断しようとするとき、最も困難 な点はその材料の割断が可能であるかどうかがわかっていな いことである.

そこで本研究では、サファイアウエハのレーザ割断の可能 性について調べることにした.また、曲線状に割断することに より、結晶方位の影響について検討した.さらに、ウエハ上に 細い溝を加工しておき、その溝に沿ってレーザを照射するこ とによりウエハを割断する方法についても検討した.

2. 実験方法

2.1 サファイア基板

表1にサファイアの物性値を示す.シリコンウエハに比べて 熱膨張率が小さく,熱伝導率(熱拡散率)が大きいことから熱 応力を生じにくい材料である.また,破壊靱性値が大きいこと

- *1 金沢大学理工研究域:〒920-1192 石川県金沢市角間町 Kanazawa University
- *2 金沢大学大学院:〒920-1192 石川県金沢市角間町 Kanazawa University
- *3 三星ダイヤモンド工業㈱:〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-9-23 Mitsuboshi Diamond Industrial Co., Ltd.

《学会受付日:2011年2月28日》

から,シリコンウエハやガラスに比較して亀裂が進展しにくい 材料であり,これらの材料に比べて割断しにくいことがわかる. 一方,ビッカース硬さが Hv2000 以上と非常に硬く,ダイヤモ ンドブレードでは切断しにくい材料であることがわかる.

図1に厚み0.5mmのサファイアウエハの分光透過特性を示 す. 波長6µm以下の赤外線に対しては非常によい透過度を 持っているが、7µm以上の長波長に対してはほぼ100%吸収 することかわかる. そこで、本研究では波長が10.6µmのCO₂ パルスレーザを用いることにする.

図2(a)にサファイアの結晶構造を示す.サファイアウエハは 六方晶をしており、多くはC軸に垂直なC面を使っている.そこ で、本研究では図2(b)に示すように、C面で結晶方位<0001> のサファイアを用いた.加工物送り方向は<2-1-10>方向として

表1 サファイアの物性値		
厚み (µm)	125	
ヤング率(GPa)	4.7×10^{4}	
熱膨張率 (1/K)	5.3×10 ⁻⁶ (C-平行)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.5×10 ⁻⁶ (C-垂直)	
熱伝導率 (W/m・K)	41.9	
比熱 (J/kg・K)	760	
ビッカース硬さ Hv	1800 - 2100	
破壞靱性値 Kc (MPa·m ^{0.5})	1.96	



表 2 実験条件

レーザ光		CO ₂ レーザ
照射モード		パルス発振
波長 (μm)	λ	10.6
周波数 (Hz)	f	200
デフォーカス (mm)	df	+5, +10
平均出力 (W)	0	3 - 5







2.2 実験方法

移動台上に放熱用のアルミニウム板を設置し、その上にサファイアウエハを固定する。ウエハにレーザを照射しながら一定速度で移動することで、レーザ割断を行う。実験条件を表2 に示す.レーザ光には、サファイアの分光透過特性を考慮して、パルス発振のCO2レーザを用いており、周波数は200Hzである。割断は、レーザ照射エネルギとデフォーカスdfを調整して行う。ウエハに導入する初期き裂は9.81Nの荷重でビッカース圧子を3個直列に打ち込むことによって導入している。すなわち、試料始端から200μmの位置に1個目、100μmの間隔を空けて2個目、さらに100μmの間隔を空けて3個目の圧子を打つことで導入した。

3. 実験結果

3.1 サファイアウエハの割断

図3はレーザパワーQ=3W, ウエハ移動速度V=20mm/sで 割断した結果である. デフォーカスdf =+5mmとしていることか



図4 割断面のプロファイル (Ra =1.08 µm, Rz =4.02 µm)



0.25 mm (a) サファイアの割断面



らウエハ上でのビーム径は0.48mmである. 図より, レーザ照 射面に熱損傷を残すことなく, 割断できていることがわかる. 割断面には規則的な縞模様が見られる. この割断面のプロフ ィルを非接触表面粗さ計(Zygo社製:New View 5032)で測定 した結果を図4に示す. き裂進展に伴って生じる縞模様が測 定されている. *Ra*で1μmを超える値となっているが, この模様 を抑えることができれば*Ra*を0.2μm程度に抑えることができる と考えられる.

図5は割断面の縞模様について調べており,移動速度Vを 変化させて割断したときの縞模様の波長を測定した結果であ る.波長は移動速度に比例して大きくなっていることから1パ







ルスごとにき裂が進展していると考えることができる. このよう な縞模様は単結晶であるシリコンウエハの割断で観察される が⁴⁾, 非晶質のガラスでは観察されない⁶⁾. サファイアウエハも 単結晶であることから, 単結晶ウエハに特有な現象といえる.

3.2 曲線割断

サファイアウエハの曲線割断を試みた.大きなサイズのウエ ハが入手できないことから、図6に示すように、直径20mmの円 弧の一部を切り出している.試料面は(0001)面であり、Q=4W、 V=10mm/s、デフォーカスdf=+5mmで加工している.

割断した結果を図7に示す.図より明かなように円弧の割断 が可能なことがわかるが,割断面にはうねりが生じており,ま たパルス照射に起因したと考えられる縞模様が生じている. 縞模様は一様ではなく,結晶方位の影響を受けていると考え られる.非晶質のガラスの割断では,このようなうねりや縞模 様を生じることはない.

3.3 溝加工されたサファイアウエハの割断

ビッカース圧子で初期き裂を入れる代わりに,前もって短 波長レーザでウエハ面上にレーザスクライビングによって溝を 加工し,その溝に沿ってCO₂レーザを照射し(*V*=5mm/s, *Q*=4W,デフォーカス*df*=+10mm<ビーム径=0.70mm>),その



時生じる熱応力を活用してウエハを割断している.割断面の 顕微鏡写真を図8に示す.図からわかるように、割断面の上部 に前もって導入された溝跡が残っている.溝加工には波長 355nmのNd:YAGレーザ3倍波(移動速度V=15mm/s,レーザ パワーQ=0.5W)を用いており、溝の幅は7.2µm,深さは 20.7µmである¹⁾.図8に見るように、溝に沿ってウエハが分断さ れ、良好な割断面が得られていることがわかる.また、割断面 には、CO2レーザのパルスに同期した波模様が形成されてお り、図3と同様の傾向を示している.したがって、初期き裂の代 わりに溝を加工する方法も有効であるが、溝加工のために短 波長レーザを準備し、溝加工する工程が必要となる.

4. 結 言

CO₂パルスレーザを用いて単結晶のサファイアウエハの熱 応力割断を試みた.得られた結果をまとめると次のようにな る.

- CO₂レーザにより、サファイアウエハを熱応力割断すること ができ、サファイアウエハを分断する加工として有力な加 工法であるといえる.
- パルスレーザを用いると、パルスの周期に起因した縞模様 が割断面に形成される.この傾向は、単結晶ウエハに特 有な傾向である.
- 3)曲線割断が可能であり、円弧状にサファイアウエハを割断できる。割断面にはうねりや縞模様が形成され、結晶方位の影響を受ける。
- 4) ビッカース圧子による初期き裂の代わりに、ウエハ上に浅 い溝を付けておき、その上をCO2パルスレーザでなぞるこ とにより、ウエハを割断できる.

5. 参考文献

- S. Nagatomo, J. Ogawa, A. Saijo and N. K.riyama: Laser Scribing of the Hard and Brittle Materials, Proceeding of the 65th Laser Materials Proceeding Conference, (2005) 207 (in Japanese).
- M. Sugata: Laser Scribing Methods of the Sapphire Substrate, J. Jpn. Soc. Abras. Technol., 49, 4 (2005) 191 (in Japanese).
- T. Ueda, K. Yamada, K. Oiso and A. Hosokawa: Thermal Stress Cleaving of Brittle Materials by Laser Beam, CIRP Ann., 51, 1 (2002) 149.
- 4) T. Ueda, K.Tanaka, S.Nishioka, K.Yamada and A.Hosokawa: Laser Cleaving of Wafer for Electric Devices, J. Jpn. Soc. Precis. Eng., 75, 3, (2009) 443 (in Japanese).
- 5) T.Ueda, S. Nishioka, K. Tanaka, K. Yamada and A. Hosokawa: Laser Cleaving of Ceramics, J. Jpn. Soc. Abras. Technol. 53, 2 (2009) 111 (in Japanese).
- 6) T. Kurobe, N. Kawamukai and T. Takao: Breaking of Transparent Glass Plate by Irradiation of YAG Laser, J. Soc. Mat. Sci., 42, 479 (1993) 1004 (in Japanese).